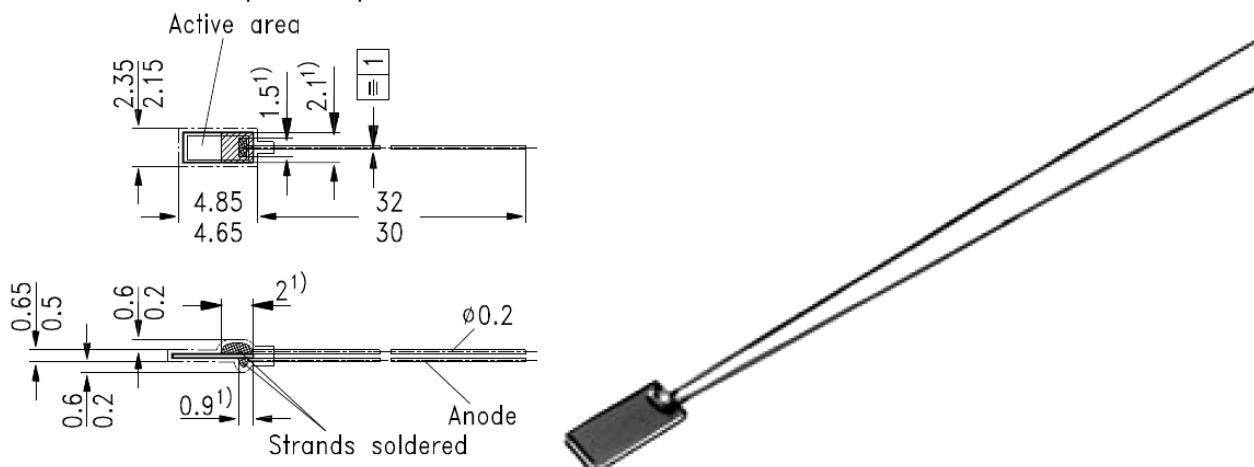


Diode and solder pads lacquered



1) Max. solder areas on front  
and back side

Approx. weight 0.1 g

Bezeichnung <b>Description</b>	Symbol <b>Symbol</b>	Wert <b>Value</b>	Einheit <b>Unit</b>
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit <i>Wavelength of max. sensitivity</i>	$\lambda_{S\max}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\% \text{ von } S_{\max}$ <i>Spectral range of sensitivity</i> $S = 10\% \text{ of } S_{\max}$	$\lambda$	420 ... 1060	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche <i>Radiant sensitive area</i>	$A$	7.6	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Fläche <i>Dimensions of radiant sensitive area</i>	$L \times B$ $L \times W$	1.95 × 4.45	mm
Halbwinkel <i>Half angle</i>	$\varphi$	± 60	Grad deg.
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes <i>Rise and fall time of the photocurrent</i> $R_L = 1 \text{ k}\Omega; V_R = 1 \text{ V}; \lambda = 850 \text{ nm}; I_p = 50 \mu\text{A}$	$t_r, t_f$	3	μs
Temperaturkoeffizient von $V_O$ <i>Temperature coefficient of <math>V_O</math></i>	$TC_V$	- 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$ <i>Temperature coefficient of <math>I_{SC}</math></i>	$TC_I$	0.12	%/K
Kapazität, $V_R = 1 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}, E = 0$ <i>Capacitance</i>	$C_0$	0.8	nF
Leerlaufspannung, $E_v = 1000 \text{ lx}$ <i>Open-circuit voltage</i>	$V_O$	60 - 440	mV
Kurzschlußstrom, $E_v = 1000 \text{ lx}$ <i>Short-circuit current</i>	$I_{SC}$	20 - 60	μA